

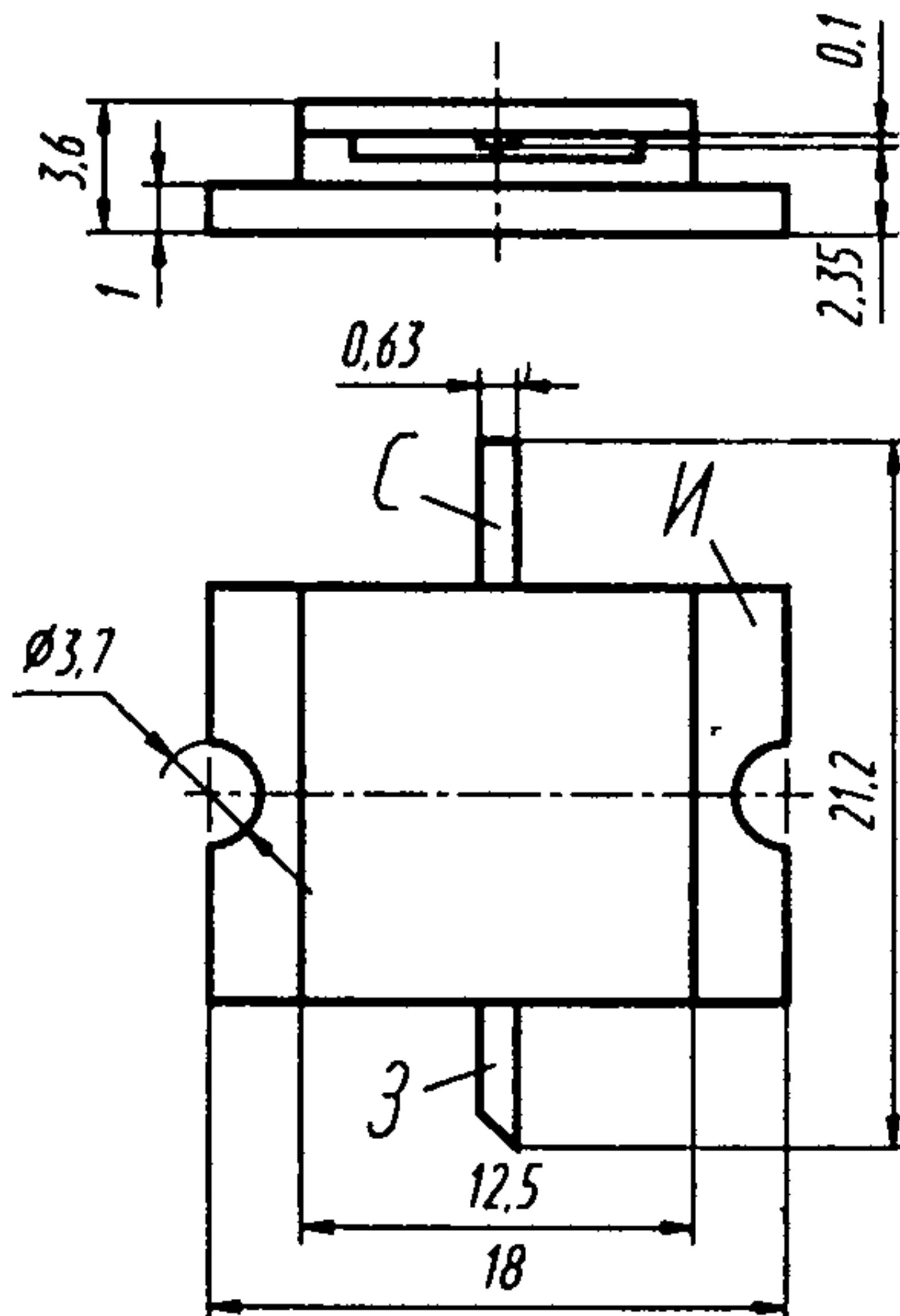
A726A, A726B

Транзисторы арсенидогаллиевые полевые эпитаксиально-планарные с затвором в виде барьера Шотки с каналом л-типа генераторные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 3,7...4,2 ГГц для A726A, 4,3...4,8 ГГц для A726B в тракте с волновым сопротивлением 50 Ом в герметизированной аппаратуре. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на кристаллодержателе.

Масса транзистора не более 5 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

A726 (A, B)



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{СИ} = 7$ В, $Z_{ВХ} = Z_{ВЫХ} = 50$ Ом, $P_{ВХ} = 0,7$ Вт, $T_K = +25$ °С, не менее:

А726А, $\Delta f = 3,7...4,2$ ГГц	2 Вт
А726Б, $\Delta f = 4,3...4,8$ ГГц	2 Вт

Коэффициент усиления по мощности при $U_{СИ} = 7$ В, $Z_{ВХ} = Z_{ВЫХ} = 50$ Ом, $P_{ВХ} = 0,7$ Вт, $T_K = +25$ °С, не менее:

А726А, $\Delta f = 3,7...4,2$ ГГц	4,5 дБ
А726Б, $\Delta f = 4,3...4,8$ ГГц	4,5 дБ

Коэффициент полезного действия при $U_{СИ} = 7$ В, $Z_{ВХ} = Z_{ВЫХ} = 50$ Ом, $P_{ВХ} = 0,7$ Вт, $T_K = +25$ °С, не менее:

А726А, $\Delta f = 3,7...4,2$ ГГц	25%
А726Б, $\Delta f = 4,3...4,8$ ГГц	25%

Крутизна характеристики при $U_{СИ} = 3$ В, $I_C = 1,8$ А, не менее

300 мА/В

Ток утечки затвора при $U_{ЗИ} = -5$ В, не более .

0,1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток ¹ при $T_K = -60...+85$ °С	8 В
Постоянное напряжение затвор—исток	5 В
Постоянная рассеиваемая мощность и средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме ² при $T_K = -60...+25$ °С	7 Вт
Температура кристалла	+150 °С
Тепловое сопротивление кристалл—корпус.....	18 °С/Вт
Температура окружающей среды	-60... $T_K = +125$ °С

¹ При $T_K > +85$ °С $U_{СИ, МАКС} = 7$ В.

² При $T_K > +25$ °С максимально допустимые рассеиваемые мощности рассчитываются по формуле

$$P_{МАКС} = P_{СР, МАКС} = (150 - T_K) / 18, \text{ Вт};$$

$$P_{СР, МАКС} = U_{СИ} I_C - (P_{ВЫХ} - P_{ВХ}), \text{ Вт}.$$

Расстояние места пайки выводов до кристаллодержателя не менее 2 мм, температура пайки не выше +260 °С в течение не более 3 с. Допускается пайка или сварка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от кристаллодержателя при температуре пайки не выше +150 °С в течение не более 3 с.